



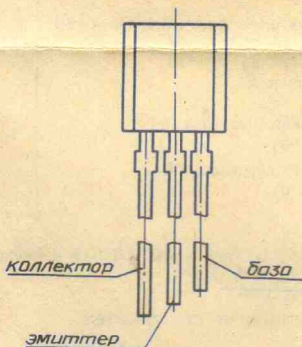
ТРАНЗИСТОРЫ КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные $n-p-n$ -транзисторы КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в усилительных схемах устройств широкого применения.

Вид климатического исполнения УХЛ 2.1.

Схема расположения выводов



Условная маркировка: КТ325АМ — 325А
КТ325БМ — 325Б
КТ325ВМ — 325В

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t = (25 \pm 10)^\circ \text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, тип транзистора	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}$)		
КТ325АМ	30	90
КТ325БМ	70	210
КТ325ВМ	160	400
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{\text{КБ}} = 15 \text{ В}$)	—	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{\text{ЭБ}} = 4 \text{ В}$)	—	0,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте		
($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$, $f = 10^8 \text{ Гц}$)		
КТ325АМ, КТ325БМ	8	—
КТ325ВМ	10	—
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс		
($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$, $f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	125
Граничное напряжение, В ($I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$)	15	—
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$, $f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	2,5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{\text{ЭБ}} = 4 \text{ В}$, $f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	2,5

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

золото — *1,2494*
1,2264 г.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ соответствуют техническим условиям 0.336.047 ТУ.

Приняты по извещению № _____

от _____

дата

КТ 325 БМ

Место для простановки
конкретного типа транзисторов,
находящихся в данной упаковке

Место для штампа ОТК,
год и месяц изготовления

ОТК 61
4-91

